

С 7 по 12 сентября в Одессе проходила Международная научно-практическая конференция «СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» («ССПОИ-98»). Организаторы конференции — Академия связи Украины, Одесское ОАО «Нептун», Украинская государственная академия связи им. А. С. Попова, редакция журнала «ТКЭА», Одесский государственный политехнический университет, Одесская государственная академия холода. Это уже вторая конференция (первая состоялась в 1997 г.), цель которой — организация непосредственного контакта разработчиков, изготовителей и потенциальных потребителей средств передачи и обработки информации, поддержание связей между разработчиками и изготовителями аппаратуры, компонентов и материалов электроники в странах СНГ.

На конференции были представлены доклады по следующим направлениям:

- ♦ средства передачи и обработки информации;

- ♦ конструирование и производство аппаратуры;
- ♦ электронные компоненты и материалы для них.

В конференции приняли участие ученые и специалисты НИИ, КБ и вузов Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Молдовы, России и Украины. Ряд докладов был рекомендован к опубликованию в международном научно-техническом журнале «Технология и конструирование в электронной аппаратуре» («ТКЭА»).

Учитывая общее стремление к возрождению электронных отраслей промышленности в Украине, конференция высказалась за создание ассоциации разработчиков и производителей РЭС (включая микроэлектронику), которая способствовала бы информационному и организационному сближению научно-производственных учреждений и предприятий.

Принято решение провести в 1999 г. 3-ю конференцию — «ССПОИ-99», в рамках которой организовать деловые встречи и практические семинары.

К. т. н. И. П. МАЛЯВИН



планар
КБТЭМ-ОМО

Многоканальный лазерный генератор изображений ЭМ-5299Б

Предназначен для прямой генерации изображений на полупроводниковых пластинах.

Позволяет:

- ♦ выполнять специализацию слоя межсоединений в производстве полужаказных СБИС;
- ♦ осуществлять последовательный перенос информации из САПР на пластины и изготавливать любые слои для заказных СБИС.

НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦЕНТРЫ СНГ

Размер минимального элемента	800 нм
Адресная сетка	25 нм/50 нм
Неровность края:	
при дискретности адресации 25 нм	50 нм
при дискретности адресации 50 нм	100 нм
Погрешность совмещения слоев (2 σ)	100 нм
Воспроизводимость размеров (3 σ)	50 нм
Погрешность размеров	50 нм
Время экспонирования пластины диаметром 100 мм:	
при дискретности адресации 25 нм	40 мин
при дискретности адресации 50 нм	20 мин
Размеры области экспонирования	200×200 мм